Каталог продукции

Пассивные РЧ-сети и компоненты импеданса

Инженерный выбор РЧ-нагрузок, терминаторов, согласующих и выравнивающих сетей по частоте, плоскости отсчёта, отражению, мощности, температуре и условиям эксплуатации.



Продукция: 11

Редакция: 6 · Дата редакции: 2026-11-11

RF резисторы



LCRES-R15OHM

15 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 15 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.35 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.8 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

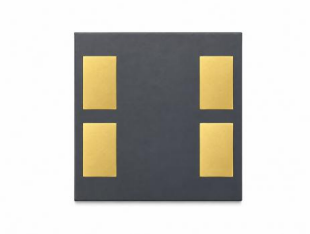
Количество выводов: Значение: 2

Сопротивление: Типовое: 15; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 20 / 20 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.165 / 0.165 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.33 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 2

Количество выводов: Значение: 4

Сопротивление: Типовое: 20 / 20; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-R50OHM

50 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 50 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.2 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.6 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

Количество выводов: Значение: 2

Сопротивление: Типовое: 50; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCRES-R1000OHM

1000 Ω Кристалл тонкоплёночного резистора GaAs

Сопротивление: 1000 Ω (типовое); Рабочий ток в линейном режиме: 0.04 A (типовое); Максимально допустимый ток: 0.08 A (максимальное). Размеры кристалла в плане: 0.5 × 0.5 mm.

Количество резисторов: Значение: 1

Количество выводов: Значение: 2

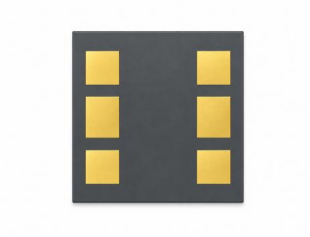
Сопротивление: Типовое: 1000; Единица: Ω

Допуск сопротивления: Типовое: ±5; Единица: %

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

RF конденсаторы



LCCAP-C10PF

10 pF Кристалл конденсатора GaAs

Ёмкость: 10 pF (типовое); Выдерживаемое напряжение: 50 V (типовое). Размеры кристалла: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

Ёмкость: Типовое: 10; Единица: pF; TA = +25 °C

Выдерживаемое напряжение: Типовое: 50; Единица: V; TA = +25 °C

Напряжение пробоя: Значение: 80 (Vb); Единица: V

Температура хранения: Минимум: -65; Максимум: 150; Единица: °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

RF-эквалайзеры



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz Кристалл наклонного эквалайзера GaAs

Величина коррекции: 2 dB; Вносимые потери @ 8000 MHz: 2.6 dB; Вносимые потери @ 12000 MHz: 0.7 dB. Размеры кристалла: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

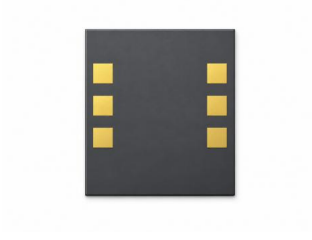
Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Величина коррекции: Значение: 2; Единица: dB

Вносимые потери @ 8000 MHz: Значение: 2.6; Единица: dB

Вносимые потери @ 12000 MHz: Значение: 0.7; Единица: dB

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz Кристалл наклонного эквалайзера GaAs

Величина коррекции: 5.5 dB; Вносимые потери @ 2000 MHz: 0.6 dB; Вносимые потери @ 6000 MHz: 6.1 dB. Размеры кристалла: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

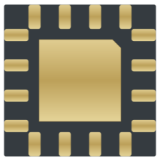
Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

Величина коррекции: Значение: 5.5; Единица: dB

Вносимые потери @ 2000 MHz: Значение: 0.6; Единица: dB

Вносимые потери @ 6000 MHz: Значение: 6.1; Единица: dB

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCEQ-8000-12000-C

8000–12000 MHz RF-эквалайзер в корпусе — ΔIL 2 dB; IL -3.1 → -1.1 dB (типовое)

8000–12000 MHz; Величина выравнивания 2 dB (типовое); Вносимые потери на нижней границе полосы -3.1 dB (типовое) @ 8000 MHz; Вносимые потери на верхней границе полосы -1.1 dB (типовое) @ 12000 MHz.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

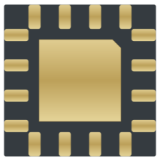
Вносимые потери на нижней границе полосы: Типовое: -3.1; Значение: f = 8000 MHz; Единица: dB

Вносимые потери на верхней границе полосы: Типовое: -1.1; Значение: f = 12000 MHz; Единица: dB

Величина выравнивания: Типовое: 2; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCEQ-2000-6000-C

2000–6000 MHz RF-эквалайзер в корпусе — ΔIL 5.5 dB; IL -1 → -6.5 dB (типовое)

2000–6000 MHz; Величина выравнивания 5.5 dB (типовое); Вносимые потери на нижней границе полосы -1 dB (типовое) @ 2000 MHz; Вносимые потери на верхней границе полосы -6.5 dB (типовое) @ 6000 MHz.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

Вносимые потери на нижней границе полосы: Типовое: -1; Значение: f = 2000 MHz; Единица: dB

Вносимые потери на верхней границе полосы: Типовое: -6.5; Значение: f = 6000 MHz; Единица: dB

Величина выравнивания: Типовое: 5.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz Кристалл перекрёстного соединителя RF GaAs

Вносимые потери: 0.4 dB (типовое); Развязка: 30 dB (типовое); Возвратные потери: 20 dB (типовое). Размеры кристалла: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 40000; Значение: DC–40000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.4; Единица: dB

Развязка: Типовое: 30; Единица: dB

Возвратные потери: Типовое: 20; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

РЧ-нагрузки и эквиваленты нагрузки



LCLOAD-6000-25

RF-нагрузка 25 W, DC–6 GHz

Согласованная нагрузка 50 Ω для DC–6 GHz. Типовая допустимая мощность CW — 25 W, минимальная — 20 W; типовой КСВН — 1,3:1.

Рабочая частота: Минимум: DC; Максимум: 6000; Единица: MHz

Допустимая мощность RF в режиме CW: Минимум: 20; Типовое: 25; Единица: W

КСВН: Типовое: 1.3:1

Импеданс: Типовое: 50; Единица: Ω

25 °C; 50 Ω

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию

документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.